硬X線励起の深い内殻準位からの光電子計測の開発

極限計測ユニット 表面化学分析グループ 吉川英樹

1. 背景・目的

硬X線光電子分光法(HArd X-ray PhotoElectron Spectroscopy: HAXPES)は、20~30 nm の深さまで の試料の組成,化学状態,電子状態を非破壊で解析する手法として学術的にも産業的にもその有用性 が広く認識されつつある。ただし、その硬X線光電子分光法で観察される主な光電子ピークは、結合 エネルギー1.4 keV 以下の浅い内殻準位からのものであり、それよりも大きな結合エネルギーを持つ深 い内殻準位からの光電子ピークについては観察されることは少なかった。これは、浅い内殻準位から の光電子については、軟X線励起による光電子分光(X-ray Photoelectron Spectroscopy: XPS)の長い歴 史のおかけで各物質における光電子ピークの化学シフト量について文献値が既に存在しているのに対 して、深い内殻準位からの光電子については、この化学シフト量について文献値が非常に少ないこと に由来している。本研究は、硬X線光電子分光法における新しい計測モードとして、深い内殻準位を 計測することの利点を明らかにすることで、深い内殻準位からの光電子スペクトルの利用を行い、深

2. 研究成果

図1にSe, Ti, Pt, Pd, Sの各元素の主要原子軌道の 光イオン化断面積の励起X線エネルギー依存性の理論 値を示す(縦軸と横軸は対数表示)。この図から分かる ように、X線のエネルギーが大きくなると共に光イオ ン化断面積は指数関数的に減少している。通常、X線 光電子分光では、結合エネルギー1.4 keV 以下の浅い 内殻準位(図中の"shallow core")を計測するため、X 線のエネルギーが2keV以下の軟X線光電子分光では, 実用的な感度が得られても、X線のエネルギーが6 keV 以上の硬X線光電子分光となると2桁以上も小さ い感度しか得られない。その問題を解決する方法とし て、図1中の"deep core"と記載した深い内殻準位から の光電子を観察する方法がある。硬X線光電子分光で 計測する"deep core"の光イオン化断面積は、軟X線光 電子分光で計測する"shallow core"の光イオン化断面 積と同程度の値を持つため、実用的に優れている。



図1 Se, Ti, Pt, Pd, Sの各元素の主要原子軌 道の光イオン化断面積の励起X線エネルギ 一依存性 [1]

図2に深い内殻準位を6keVのX線を使った硬X線光電子分光で観察した例を示す。OH 基で終端 された異なる世代のデンドリマーとPt₃Tiナノ粒子を水溶液中に共分散させた試料について、Pt₃Tiナ ノ粒子がデンドリマー中に内包されている かどうかを実証するために行った Pt 3d 光電 子ピーク(結合エネルギー2122~2125 eV) の計測結果である[2]。なお、デンドリマーは 世代が大きくなるにつれてサイズが大きく なる。図2の結果から、第5世代のOH 基終 端デンドリマー(G5OH)とPt₃Tiナノ粒子 を共分散させた試料のみPt 3d ピークが高結 合エネルギー側にシフトしている。これは微 視的空間内でナノ粒子が基板から電気絶縁 されている場合に起こる final state 効果であ り、Pt₃Tiナノ粒子が第5世代のOH 基終端 デンドリマーに内包されていることを示し ている。通常、Pt の光電子スペクトルの観察 には Pt 4f ピークを用いるが、Pt₃Tiナノ粒子



図 2 6 keV のX線を使った硬X線光電子分光によ る Pt 3d の光電子ピーク。第 2 世代の OH 基終端デ ンドリマ— (G2OH) や第 5 世代の OH 基終端デン ドリマ—(G5OH)と Pt₃Ti ナノ粒子を共分散した試料 での結果。参照試料として, Pt₃Ti ナノ粒子と Pt₃Ti バルクの結果も示している。[2]

の量が極微量であったため Pt 4f ピークは観察が困難であった。そこで、光イオン化断面積の大きな Pt 3d ピークを用いることでピークの検知と結合エネルギーの変化を観察することができた。このこと は、図1にある6keVのX線に対する Pt 4f と Pt 3d の光イオン化断面積の大きな違いから理解できる。

図2の結果は、深い内殻準位を観察することで極微量ナノ物質の電子状態を明瞭に観察したもので あるが、組成の定量値については議論しなかった。硬X線光電子分光において定量分析は、実用上重 要であるため、本研究では深い内殻準位の高感度観察だけでなく定量評価を行う基盤構築も行った。 具体的には、光イオン化断面積および非対称パラメーターから各元素の各原子軌道からの光電子の感 度係数を求め、それをデータベース化する作業を行った。光電子の光イオン化断面積については、式(1) ~(3)の近似式[3,4]を用いた。

$$\sigma_{nl}(E) = \sigma_0 \cdot F\left(\frac{E}{E_0}\right) \tag{1}$$

$$F(y) = (y-1)^2 y^{-Q} \left(1 + \sqrt{y/y_a}\right)^{-P}$$
(2)

$$Q \equiv 5.5 + l - \frac{P}{2} \tag{3}$$

ここで、 $y = E/E_0$ で E はX線のエネルギで、 E_0 、 y_a 、P はフィッティングパラメーターで、l は方 位量子数で、l = 0, 1, 2 (s 軌道、p 軌道、d 軌道)となる。 $P \ge Q \ge l$ の間には、式(3)の関係がある。 式(1)~(3)は、エネルギーの大きなところで Bethe and Salpeter の式 $\sigma_{nl}(E) \propto E^{-3.5-l}$ [5]に漸近する ようになっており、この式を外挿で使用することの妥当性を担保している。なお、文献[3,4]のオリジ ナルの式では、式(2)の $(y - 1)^2$ の項が、 $(y - 1)^2 + y_w^2$ となっているが、フィッティングパラメータ ーの数を減らしたいので、現状では、X線のエネルギーが吸収端の近傍になったときに必要になる y_w^2 の項はゼロとして扱うことにした。y² の項をゼロとして扱うのは、ある内殻準位の吸収端近傍にX線のエネルギーが近い場合、光電子の運動エネルギーは小さくなるが、このような運動エネルギーの小

atomic	atomic	orbit	RE		FO	P	logK	Ya	0
No	Name	UDIL			LU	I	iogr	10	Ý
13	AI	1s	1564	0	43.28598	4.166632	13.39887	27.69956	3.416684
13	AI	2s	121	0	14.05922	6.454782	10.02993	35.82905	2.272609
13	AI	2p1	77	1	27.8708	5.742222	12.14132	30.91211	3.628889
13	AI	2p3	77	1	25.02976	5.846478	12.9711	32.23618	3.576761
14	Si	1s	1844	0	50.73378	4.043611	13.29767	29.56235	3.478194
14	Si	2s	154	0	17.47061	6.250218	9.993924	36.77814	2.374891
14	Si	2p1	104	1	28.85355	5.791611	12.25425	33.66178	3.604194
14	Si	2p3	104	1	26.14049	5.881123	13.08601	34.65611	3.559438
15	Р	1s	2148	0	56.92038	3.984503	13.22908	31.35865	3.507748
15	Р	2s	191	0	25.14529	5.885764	9.967253	34.49598	2.557118
15	Р	2p1	136	1	35.03793	5.775835	12.19521	30.54603	3.612083
15	Р	2p3	135	1	27.43783	5.796323	13.18703	39.7976	3.601839
16	S	1s	2476	0	57.83146	4.114748	13.24157	31.6487	3.442626
16	S	2s	232	0	18.51029	7.909012	9.588755	20.76989	1.545494
16	S	2p1	170	1	34.28296	5.535382	12.36517	43.00588	3.732309
16	S	2p3	168	1	28.82202	5.780107	13.26017	43.41605	3.609946
17	CI	1s	2829	0	58.71994	4.23949	13.2459	31.92524	3.380255
17	CI	2s	277	0	31.0606	5.833509	9.865552	36.10855	2.583246
17	CI	2p1	208	1	35.87531	5.45836	12.45073	49.14392	3.77082
17	CI	2p3	206	1	30.34825	5.777057	13.33387	45.89834	3.611472
18	Ar	1s	3206	0	59.79887	4.350817	13.23906	32.29519	3.324592
18	Ar	2s	326	0	35.52112	5.872572	9.787815	34.12983	2.563714
18	Ar	2p1	251	1	36.79574	5.52569	12.54636	50.58713	3.737155
18	Ar	2p3	248	1	33.48177	5.542489	13.38657	54.0148	3.728755
18	Ar	3s	29	0	16.71885	4.62593	8.957056	173.5405	3.187035
19	к	1s	3611	0	60.89201	4.463326	13.21255	32.74766	3.268337
19	к	2s	381	0	28.7534	6.164586	9.76075	40.14012	2.417707
19	К	2p1	299	1	43.18747	5.440653	12.42853	50.70682	3.779674
19	К	2p3	296	1	41.71724	5.375978	13.20452	53.37552	3.812011
19	К	3s	37	0	11.12709	4.817393	9.338802	249.8075	3.091303

テーブル 1 原子番号 13~19 における光イオン化断面積を定式化した際の各パラメーターの値

い光電子を HAXPES では扱う必要が無いためである。

この近似式を使って、軟X線光電子分光から硬X線光電子分光まで利用できる光イオン化断面積の 値のテーブルを作成したので、その一例をテーブル1に示す。このテーブルに加えて、多極子遷移ま で考慮した光電子の非対称パラメータ、光電子の非弾性平均自由行程までを考慮して、光電子の感度 係数を求めた。なお、感度係数の算出にあたり、電子分光の感度係数に関する国際標準規格である ISO 18118 "Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy - Guide to the use of experimentally determined relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials"に準拠した。この結果は、論文として発表すると共に、データベースとして一般公開する予 定である。

3. 展望

硬X線光電子分光において深い内殻準位の光電子ピークの利用は、%オーダーに留まっている XPS の微量元素の化学状態分析の検出下限を大幅に下げる可能性につながり、学術利用だけでなく工業利用の面でも重要である。本研究によってデータベース化する感度係数は、微量元素の化学状態分析の定量分析に直結しており、それを組み込んだソフトウェアの開発を行うことで、将来の微量元素の化学状態の high-throughput 計測が実現すると期待される。

参考文献

[1] H. Yoshikawa, I. Matolínová, V. Matolín, J Electron Spectrosc Relat Phenom 190 (2013) 127.

[2] G. Saravanan, T. Hara, H. Yoshikawa, Y. Yamashita, S. Ueda, K. Kobayashi and H. Abe, Chem.Commun. 48 (2012) 7441.

[3] D. A. Verner and D. G. Yakovlev, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 109, 125-133 (1995).

[4] D. A. Verner, G. J. Ferland, K. T. Korista and D. G. Yakovlev, Astrophysical Journal **465**, 487-498 (1996).

[5] H. A. Bethe and E. E. Salpeter, Quantum Mechanics of One and Two Electron Atoms (Springer, Berlin, Heidelberg, New York)